3D打印与激光烧结介质+导体双层厚膜显微结构研究

吴向东^{1,2} 刘俊夫^{1,2} 王之巍³ 张 景¹
1. 中国电子科技集团公司第四十三研究所 安徽 合肥 230088
2. 微系统安徽省重点实验室 安徽 合肥 230088
3. 合肥工业大学材料工程学院 安徽 合肥 230088

摘 要:为拓展3D打印工艺在厚膜混合集成电路领域的应用,提升厚膜烧结效率和工艺研发效率,本文采用3D 直写+激光烧结法制备介质+导体浆料双层复合厚膜,并与用传统丝网印刷+高温炉烧结方法制备的相同浆料双层厚膜 样品进行对比实验,对其显微结构进行评价。结果表明,两种工艺制备的介质+导体厚膜表面平整连续,厚度均匀, 但3D直写+激光烧结形成的厚膜导体孔隙较多,介质浆料厚膜烧结程度较低。3D直写制备厚膜导体和介质浆料具有可 行性,对介质浆料厚膜而言,除了激光烧结参数的优化外,可以通过高温炉二次烧结进行后处理,以图实现烧结致密 化,提高其与基板间的结合强度。

关键词:厚膜混合集成电路; 3D直写; 激光烧结; 显微结构

引言

混合集成电路(Hybrid Integrated Circuit, HIC)技 术是指在单一的封装内通过厚薄膜技术、微组装技术, 将半导体集成电路(IC)、无源器件及其他器件集成一 体,实现定制功能电路的集成技术。厚膜基板是HIC形成 电气互联的重要载体,厚膜基板的布线密度和质量决定 了产品的组装密度和可靠性。传统厚膜多层布线陶瓷基 板历经印制、烘干和烧结等多道工序,制程复杂、环境 和设备成本高。3D打印属于一种快速成型技术,具有研 发成本低、节约原材料、制造周期短、便于制造多层复 杂结构件和功能器件等显著优点^[1]。Ackstaller等^[2]选用六 种不同的材料组合分别进行实验,打印了一种光学耦合 器。这种器件可以印刷在陶瓷基板上,嵌入不同结构的 HIC中。

值得注意的是,浆料厚膜的成形一般需通过长时间 的烧结来实现。激光烧结具有烧结速度快,烧结点小等 优势,可实现逐层的快速烧结。一般分为四个阶段:1) 厚膜中的有机物挥发分解,促使颗粒紧密接触排列;2) 颗粒局部熔化,液相薄膜促进原子扩散,烧结颈长大; 3)塑性变形的颗粒分割、填充大的孔隙;4)微观缺陷 消失,进一步促进烧结致密化^[3]。激光烧结是在样品表面 瞬间凝聚高温而实现浆料膜层的迅速烧结^[4]。关于激光烧 结厚膜浆料的结构与性能方面及不同材料烧结工艺优化 方面的研究还比较欠缺。

本文以导体浆料和介质浆料作为原料,使用3D直写 打印+激光烧结工艺分别在96%Al₂O₃陶瓷基板上制备介 质+导体双层厚膜,开展厚膜显微组织结构研究,并与传 统的丝网印刷+高温炉烧结所制备的同种浆料厚膜进行 比对,为促进3D打印技术在厚膜电路设计、制造上的应 用,开展有益的探讨。

1 实验材料与方法

1.1 实验材料与样品制备

厚膜HIC要求浆料焊接性好,对导体浆料而言, Pt、Au都是化学性质稳定的金属,而且纯Ag浆料在搭接 区会产生Ag离子的扩散现象^[5],较为常用的是Ag、Pt-Ag、Pd-Ag或Pd-Pt-Ag等贵金属浆料^[6]。本实验以某进口 Pt-Ag导体浆料和以低熔玻璃(Si和Al等元素的氧化物) 为主要组成的介质浆料为原料,采用3D直写法在某国产 96%Al₂O₃陶瓷基板上均匀印制介质厚膜,后将其连同陶 瓷基板在100℃下保温15min干燥后,使用纳秒激光器进 行激光烧结。烧结完成后,在其上重复上述步骤制备一 层导体厚膜,最终获得介质+导体双层厚膜样品。其直写 参数与烧结参数如表1表2所示。其中由于介质浆料对于 纳秒激光的吸光度和导体浆料相比较差,对于激光能量 的吸收效率更差,故在实验中升高热台温度,使其能够 更好地进行激光烧结。

表1 厚膜浆料直写打印参数

浆料 类型	打印头内径 (mm)	打印头高度 (mm)	驱动气压 (MPa)	直写速度 (mm/s)	搭接间距 (mm)
导体 浆料	0.17	0.02	0.3	5	0.07
介质 浆料	0.2	0.03	0.4	7	0.08

表2 厚膜浆科激光烧结梦数								
牧	激光功率	扫描速率	扫描间距	热台温度				
水件天空	(W)	(mm/s)	(mm)	(℃)				
导体浆料	8.9	1	0.03	室温				
介质浆料	15.3	1	0.02	300				

1.2 实验方法

使用激光划片机从陶瓷基板侧切割,分割厚膜样品 后,丙酮超声清洗,冷风吹干。采用ZEISS扫描电子显微 镜(SEM)观察厚膜样品表面与截面形貌,开展厚膜显 微组织结构及其对陶瓷基板界面结合状态的评价。使用 SEM自带的Oxford INCA型X射线能谱分析仪(EDS)测 试微区成分。由于介质浆料不导电,在SEM观测前需用 离子镀膜仪进行镀金处理。

2 结果与讨论

2.1 表面形貌

如图1所示,相对于丝网印刷+高温炉烧结的样品 (图1a)而言, 3D直写+激光烧结的介质+导体样品的介 质层在制样中即发生介质层与基板的脱落,界面结合差 (图1b)。



图1 (a) 丝网印刷+高温炉烧结和3D直写+激光烧结 (b)介质+导体浆料复合厚膜样品

2.1.1 导体浆料厚膜

导体厚膜浆料由导电相、粘结相、有机载体组成⁷⁷。 在烧结过程中,有机载体挥发,粘结相(也即玻璃相) 逐渐熔融形成熔体, 润湿导体颗粒并在重力的作用下逐 渐下沉至陶瓷基板表面,在导体层与基板间形成玻璃相 粘结层,形成强结合界面,提高导体厚膜与基板的附着 力^[8]。同时借助导体颗粒间玻璃相熔体的毛细管力作用, 产生粘性压紧效应,实现导体颗粒重排,形成紧密堆 积,进而促进烧结致密化,形成连续导体层,降低厚膜 方阳^[9,10]。

由图2可见,两种样品表面均平整连续,其中3D打印 +激光烧结所得导体浆料厚膜样品表面的孔隙较多,尺寸 较大, 膜层的致密度较低(图2b); 相比之下, 丝网印 刷+高温炉烧结的样品烧结明显,孔隙较少,尺寸较小, 晶粒尺寸也较大,膜层的致密度较高(图2a)。



图2 丝网印刷+高温炉烧结(a)和3D直写+激光烧结 (b) 的导体厚膜SEM像

2.1.2 介质浆料厚膜

由图3可见,丝网印刷+高温炉烧结的介质厚膜表面 致密、平整,表面稀疏地分布着浮于膜层表面的玻璃相 颗粒,如图3a箭头所示。相比之下,3D直写+激光烧结所 得介质厚膜烧结不完全,在一定程度上仍保留着粉体颗 粒聚集的分布状态, 膜层致密度及其与基板间的结合均 较差。在厚膜表面有一些大颗粒的突起,导致表面粗糙 度增大(图3b)。



图3 丝网印刷+高温炉烧结(a)和3D直写+激光烧结 (b) 的介质厚膜表面SEM像

2.2 截面形貌

由图4a可见, 丝网印刷+高温炉烧结的样品界面结合 良好,但在导体/介质及介质/基板界面有少许的细小空洞 和微裂纹,此外,介质层内部有一些大小不一的气孔, 如图4a中箭头所示。如图4b所示, 3D直写+激光烧结所得 样品导体/介质界面也分布着细小的空洞和微裂纹, 但总 体上界面结合较好。但介质层与基板结合差,出现明显 的界面开裂。



图4 丝网印刷+高温炉烧结(a)和3D直写+激光烧结(b)的 介质+导体复合厚膜截面形貌

样品截面EDS测试表明, 丝网印刷+高温炉烧结及3D 直写+激光烧结样品的介质层均成分正常,由Si、Al、Ca 等元素的氧化物组成。如表3、表4所示。

电子通信与计算机科学·2023 第5卷 第6期

表3 两种样品截面介质层微区成分分析(wt%)									
制备工艺	0	Si	Al	Ca	Zn				
丝网印刷+高温炉烧结	59.66	11.76	21.46	7.12	/				
3D直写+激光烧结	45.33	15.92	22.97	2.97	2.93				

3 结论

1)3D直写+激光烧结与丝网印刷+高温炉烧结介质+ 导体复合厚膜表面均平整连续,膜层厚度都较均匀。3D 直写+激光烧结样品的导体层表面致密度较低,介质层烧 结程度较差;相比之下,丝网印刷+高温炉烧结的样品烧 结完全,致密度较高。

2)3D直写+激光烧结形成的复合厚膜中的介质层与 基板之间结合力相较丝网印刷+高温炉烧结样品差,界面 开裂。

3)激光烧结的机理是借由粉末部分熔化的液相烧结 (LPS)^[11]。对于导体浆料厚膜而言,在烧结过程中有机 载体挥发,其功能相与粘结相由于熔点不同而呈现半固 态即固液相并存体系。若粉末层未完全熔化,可能就是 激光功率不足,或扫描速度和扫描间距过大,激光能量 穿透深度不足所导致的^[12]。3D直写+激光烧结制备的介质 浆料厚膜明显欠烧,与基板界面结合差是此原因所致。

4)激光烧结加工的预合金粉末可能出现致密化不 足、组织和性能不均匀等加工问题。为了获得足够的力 学性能,可以对材料进行后处理,如炉后烧结^[13]、热等 静压(HIP)^[14]、或使用低熔点材料进行二次浸渗等。本研 究拟采用高温炉二次烧结的方法改善介质浆料厚膜的烧 结情况,以图实现完全致密化。

参考文献

[1]Rosen D, Kim S. Design and manufacturing implications of additive manufacturing[J]. Journal of Materials Engineering and Performance, 2021, 30(9): 6426-6438.

[2]Ackstaller T, Lorenz L, Nieweglowski K, et al. Combination of thick-film hybrid technology and polymer additive manufacturing for high-performance mechatronic integrated devices[J]. International Spring Seminar on Electronics Technology, 2019, 42, 1-6.

[3]徐荣琳. 纳米银浆料制备及激光快速烧结研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2017. [4]Xiang H, Zhou Z, Yang Y, et al. Fabrication of metallic patterns on ordinary polymer substrates by laser direct activation and electroless plating[J]. Surfaces and interfaces, 2022, 33: 102209.

[5] 鹿宁, 陈向红, 王妮等. 导电电极对电阻浆料阻值的 影响[J]. 电子元件与材料, 2022, 41(11): 1245-1250.

[6]张勇. 厚膜导电浆料技术[J]. 贵金属, 2001(04): 65-68.

[7]Akamatsu T, Shin W, Yamaguchi T, et al. Conductive glass sealants with Ag nanoparticles prepared by a heat reduction process[J]. Journal of non-crystalline solids, 2014, 394: 22-28.

[8]Wan C, Qin S, Qing L, et al. Formation of a highly conductive thick film by low-temperature sintering of silver paste containing a Bi2O3-B2O3-ZnO glass frit[J]. Journal of materials processing technology, 2019, 267: 61-67.

[9] 雷晴. 低温银浆料合成及其烧结性能研究[D]. 哈尔 滨: 哈尔滨工业大学, 2018.

[10]朱文丽,刘俊夫,董永平等.陶瓷基片表面Au/电 阻复合厚膜烧结起泡及其消除[J].电子元件与材料,2019, 38(12):54-61.

[11]Gu D D, Meiners W, Wissenbach K, et al. Laser additive manufacturing of metallic components: materials, processes and mechanisms[J]. International materials reviews, 2012, 57(3): 133-164.

[12]Chatterjee A N, Kumar S, Saha P. et al. An experimental design approach to selective laser sintering of low carbon steel[J]. Journal of materials processing technology, 2003, 136(1-3): 151-157.

[13]Agarwala M K, Bourell D L, Beaman J J, et al. Direct selective laser sintering of metals[J]. Rapid prototyping journal, 1995, 1(1): 26-36.

[14]Das S, Wohlert M, Beaman J J. et al. Processing of titanium net shapes by SLS HIP[J]. Materials & design, 1999, 20(2-3):115-121.

Kumar S, Kruth J P. Effect of bronze infiltration into laser sintered metallic parts[J]. Materials & design, 2007, 28(2): 400-407.